# 擬1次元系とみなした Pr<sub>2</sub>Ba<sub>4</sub>Cu<sub>7</sub>O<sub>15-8</sub>系の超伝導転移温度



平成21年度修士論文 三重大学大学院工学研究科 博士前期課程 物理工学専攻

独孤 海英

# 目次

1	序論
	はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2	朝永-ラッテェンジャー流体論
	1. 1 ハバードモデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)
	2.2 1次元電子系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)
	2.3 朝永-ラッティンジャー流体論・・・・・・・・・・・・・・・・(7)
3	解析方法と数値計算
	2.1 モデルの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(14)
	3.2 $K_{\rho}$ の解析的な計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	3.3 超伝導転移温度 <i>T<sub>c</sub></i> の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	3. 4 $YBa_2Cu_4O_8$ 系についての計算比較・・・・・・・・・・・・・・・・(21)
	3.5 $K_{\rho}$ の近似の検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4	まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(23)
5	謝辞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(24)
6	参考文献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(25)

# 1 序論

### はじめに

超伝導現象は 1911 年にカマリング・オンネス(Kamerlingh Onnes)[1]によっ て発見されて以来、固体物理学の中心的なテーマとして研究されてきた。現在 までに様々な金属材料が極低温で超伝導現象を示すことが明らかにされ、より 高い転移温度を示す材料の探索が進められてきた。金属系材料としては、現時 点でも 2001 年に秋光らによって発見された MgB<sub>2</sub> (2ホウ化マグネシウム)の示 す 39K が最高の転移温度であるが、これに対して、1986 年にベドノルツとミュ ーラーが発見した銅系酸化物系は、セラミックスという通常絶縁体であると考 えられる材料が、約 30K という高い転移温度を示したことにより驚きをもって 受けいれられ、さらにごく短期間に物質探索が進み、YBCO 系や BSCCO 系という 転移温度が液体窒素温度(77K)を越える物質が連続して発見され、超伝導フィ ーバとも呼べる現象を引き起こした。その結果、室温超伝導も夢ではないので はないかと思われた時期もあったが、1993 年の銅水銀系酸化物での転移温度 (130K 常圧力、160K 高圧)を最後に、転移温度上昇の更新は止まっている のが現状である。

超伝導状態では、電気抵抗がなくなるため、強力な電磁石や低損失送電、低 損失電子デバイスとしての実現が可能であるなど、その応用は計り知れない広 がりを持つものと期待されているが、現在実用化されているものは依然として 動作温度領域が低温にとどまっており、応用面ではまだ制約が多いため、より 高い転移温度で使える素材の開発が期待されている。

超伝導現象は上記に述べたように応用面で重要であるばかりでなく、純粋に 物理現象の観点からも大変興味深いものである。超伝導の本質はマクロな量子 現象であり、単に電気抵抗がゼロになるこということだけではなく、電子がク ーパー対を形成しボーズ凝縮という相転移を起こすことにある。

高温超伝導体においても従来型の超伝導体と同様にクーパー対が形成されて いることがわかっている。従来型超伝導では、BCS 理論[2]により、フォノンを 媒介とするクーパー対の形成機構が解明されているのに対し、高温超伝導にお けるクーパー対の形成機構に関しては、まだ完全なコンセンサスは得られてい ない。ただ高温超伝導物質中のある CuO<sub>2</sub>2 次元面内の電子系における反強磁性的 なスピンの揺らぎを媒介にしたクーパー対形成機構により、高温超伝導のメカ ニズムが理解できるという立場が、現在では主流となっている。

ごく最近、銅酸化物高温超伝導体の一種である Pr<sub>2</sub>Ba<sub>4</sub>Cu<sub>7</sub>O<sub>15-δ</sub>(以下プラセオ 系と略称)で一次元的な超伝導現象が発見され注目を集めている。普通の高温 超伝導体では銅酸化物  $CuO_2$  面が超伝導に主な寄与を与えているが、プラセオ系では Pr 原子のため  $CuO_2$  面が絶縁化され電気伝導には寄与していないと考えられており、むしろ  $CuO_2$  面に挟まれた  $CuO_2$  重鎖の寄与が大きいものとみられている[3,4]。

この1次元的なCuO2重鎖により実験的な超伝導転移温度が理論的にどこま で説明できるのか、またどのようにすれば、この物質で高い転移温度が出せる かを調べるために、この研究を行った。

# 2 朝永-ラッテェンジャー流体論

### 2.1 ハバードモデル

世の中の物質はすべて原子からなっているが、原子はさらに原子核と電子に 分けてみることができる。物質の性質を決めるのは主に原子核の周りを回る最 外殻電子である。原子どうしが互いに十分離れていれば、最外殻電子はイオン (ここでは、仮想的に原子から最外殻電子を除いたものをイオンと呼ぶことに する)に束縛されているが、二つの原子を十分近づけると電子軌道が重なり電 子は隣のイオンに移動することが可能となる。これを以下では電子のホッピン グ又はトランスファーと呼ぶことにする。(図2.1)



図2.1 最隣接のイオンにホッピングする電子

ホッピングする電子はイオン間を自由に移動することができ、電気伝導を担 うことができる。この電子のことを伝導電子と呼び、伝導電子を持つ系は金属 的な振る舞いを示す。

伝導電子のホッピングにより、瞬間的にある一つのイオン上の伝導電子数が 平均値より多くなりうる。この時、伝導電子間には強いクーロン斥力が働く。 この効果が特に大きいとき、斥力は電子の運動に大きな影響を与えるが、この ことを電子相関が強いという。またこのような電子系を強相関電子系という。

強相関電子系を記述する最も基本的なモデルはハバードモデルと呼ばれている。以下ではまずこのハバードモデルについて述べる。ハバードモデルは電子のホッピング項と電子間クーロン相互作用項の2つから成り立っており、それ ぞれ演算子で表現することができる。

たとえば、二つの原子があり各原子には一つの電子がある(水素原子)。1番目の原子にはスピン up の電子が、2番目の原子にはスピン down の電子があるとする。電子ホッピングのため1番目のスピン up の電子が2番目の原子に移動し、この時電子のホッピングを演算子 $C_{1\uparrow}c_{1\uparrow}$ で表現する。 $C_{1\uparrow}$ は1番目のサイト

の up 電子を消すのを意味し、*C*<sup>+</sup><sub>21</sub>は2番目のサイトに down 電子を生成したのを 意味するため、それぞれの消滅演算子、生成演算子と呼ぶ。ハバードモデルは 離散的なモデルであるが、長波長の極限で連続体モデルと同等となる。ここで 最隣接サイトの電子ホッピングだけを考えているので運動エネルギー項のハミ ルトニアンは次のように書ける。

$$H_{0} = -t \left[ (C_{i\uparrow}^{+} C_{j\uparrow} + C_{j\uparrow}^{+} C_{i\uparrow}) + (C_{i\downarrow}^{+} C_{j\downarrow} + C_{j\downarrow}^{+} C_{i\downarrow}) \right]$$

$$(2. 1)$$

ここでtは電子のホッピングの強さを表すトランスファーであり、電子波のオ バラップの大きさで決まる。ここまでは運動エネルギー項だけ考えたが、実際 電子間にはクーロン相互作用も働いている。離れたサイト間の相互作用は無視 し、同じサイトに電子が2コある時のみ相互作用が働くと近似すると相互作用 項のハミルトニアンは

$$H' = U \sum_{i} n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} \qquad (2.2)$$

となる。Uは相互作用ポテンシャルを表し、 $n_{i\uparrow}$ は $n_{\uparrow\uparrow} = C_{i\uparrow}^+ C_{i\uparrow}$ で、iサイト上にいる電子の個数を表す電子数演算子である。

(2.1) 式と(2.2) 式を合わせると全体のハミルトニアンである。

$$H = H_0 + H'$$
  
=  $-t \left[ (C_{i\uparrow}^+ C_{j\uparrow} + C_{j\uparrow}^+ C_{i\uparrow}) + (C_{i\downarrow}^+ C_{j\downarrow} + C_{j\downarrow}^+ C_{i\downarrow}) \right] + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}$   
(2.3)

## 2.2 1次元電子系

#### 2.2.1 低次元とは

通常、私たちが考えているのは3次元系一x軸、y軸、z軸の世界である。 そこに時間軸も加えれば4次元的になるが、物質によって1次元系か2次元系 として取り扱うことも多い。1次元(2次元)系を低次元系と呼ぶ。低次元系 にすることによって問題の取り扱いが簡単になったりする。以下に低次元にみ なせる例をいくつか挙げてみよう。薄い板(図2.2)、細長い棒(図2.3) などは3次元だが、薄膜形成や微細加工技術の発展とともに十分薄く、十分細

く作成することができるので普通に2次元系、1次元系に扱ってもよい。



図2.3 1次元系とみなせる細長い棒

他にも絶縁体と伝導体からなっているサンドイッチ(図2.4)、多数の細長 い伝導体が絶縁体に埋め込まれたもの(図2.5)、一見3次元に見えるが電子 の振る舞いに注目すればそれぞれ2次元系、1次元系であることが容易にわかる。 これらは擬2(1)次元系と言うこともある。



図2.4 擬2次元系とみなせる絶 縁体と伝導体のサンドイッチ



図2.5 擬1次元系とみなせる絶縁体に 埋め込まれた多数の細長い伝導体

これ以外も、特定の方向のみ良い電気伝導性を持つ化合物などがある。以下 の話は1次元電子系に限ることにする。

### 2.2.2 1次元電子系の特徴

まず、相互作用のない自由電子系(フェルミ粒子)を考える。この時のエネ ルギーと波数の関係は $\varepsilon_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ であり、図2.6のようにグラフで示す。

 $\mathbf{5}$ 



図2.6 相互作用のない電子系で電子がフェルミ面まで 話まった時の波数とエネルギーのグラフ

電子は基底状態から詰まり始め、フェルミ面まで電子が詰まったとする。k<sub>F</sub>は フェルミ波数を表す。運動量分布 $\langle n_{k\sigma} \rangle$ と波数kに関してのグラフは図2.7の ようである。





低温(低エネルギー)での電子系の性質の中でフェルミ面は重要である。図 2. 7では相互作用のない場合を考えているが、非常に面白いのはクーロン相 互作用(斥力U)を入れたときにフェルミ面が変化することである。しかし、 フェルミ面の変化の仕方は次元によって違う。図2.8は高次元と1次元を分 けてフェルミ面の変化を考察したものである。



でのフェルミ面変化

図2.8の(a)と(b)を比較してみると、高次元の時はフェルミ面上で運動量分布に飛びは残ってあるが、電子状態はU=0の時と連続的につながっている。つまりフェルミ液体であることが分かる。それに対して1次元の場合はフェルミ面で飛びが消えて滑らかな変化に変わる。U=0のときと連続的につながってない。これは高次元時のフェルミ液体とは違い、ラッティンジャー流体ということを示している[5,6,7,]。原因としては1次元では相互作用Uの効果が大きく、電子が互いに避けにくいからだと思われる。

### 2.3 朝永-ラッティンジャー流体論

### 2.3.1 1本鎖ハバードモデル

まず運動エネルギー項から考えることにする。1本鎖のハバードモデルを例 としての朝永-ラッティンジャー理論を説明しよう。弱く相互作用する1次元系 の基底状態の近傍では、フェルミ面近くの電子励起のみ考えればよい。ハミル トニアンは

$$H = -t\sum_{j,\sigma} (C_{j,\sigma}^+ C_{j+1,\sigma} + C_{j+1,\sigma}^+ C_{j,\sigma}) + U\sum_j n_{j\uparrow} n_{j\uparrow 1}$$
(2.4)

と書き、前の項は運動エネルギー項H<sub>0</sub>とし、後ろの項は相互作用項H'とする。 まず、運動エネルギー項H<sub>0</sub>を考えよう。

$$H_{0} = -t \sum_{j,\sigma} (C_{j,\sigma}^{+} C_{j+1,\sigma} + C_{j+1,\sigma}^{+} C_{j,\sigma})$$
 (2.5)

ここで、生成消滅演算子についてフーリエ変換

$$C_{j} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k} C_{k} e^{ik \cdot r_{j}}$$
(2.6)

を行い、式(2.6)を(2.5)に入れると

$$H_{0} = -t \frac{1}{N} \sum_{j,k,k'} (C_{k'}^{+} e^{-ik' \cdot r_{j}} \cdot C_{k} e^{ik \cdot r_{j+1}} + C_{k'}^{+} e^{-ik \cdot r_{j+1}} \cdot C_{k} e^{ik \cdot r_{j}}) \qquad (2.7)$$

このとき、k=k'のときだけゼロでなく、ほかはゼロであるため

$$H_{0} = -t \frac{1}{N} \sum_{j,k} C_{k}^{+} C_{k} e^{ik \cdot (r_{j+1} - r_{j})} + C_{k}^{+} C_{k} e^{-ik \cdot (r_{j+1} - r_{j})}$$
$$= -t \frac{1}{N} \sum_{j,k} C_{k}^{+} C_{k} \left[ e^{ik \cdot (r_{j+1} - r_{j})} + e^{-ik \cdot (r_{j+1} - r_{j})} \right]$$
(2.8)

 $r_{j}, r_{j+1}$ は電子の位置を表す演算子でイオン間距離を a とすると $r_{j} - r_{j+1} = a$ となり、

公式 
$$\cos x = \frac{1}{2} (e^{ix} + e^{-ix})$$
 を用いると  

$$H_0 = -2t \frac{1}{N} \sum_{j,k} C_k^+ C_k \cos(ka)$$

$$= -2t \sum_k C_k^+ C_k \cos(ka)$$

$$= \sum_k \varepsilon(k) C_k^+ C_k \qquad (2.9)$$

相互作用を除いて運動エネルギー項のみ考えているので自由電子系(フェル ミ粒子)と同じく考えればよい。自由電子モデルではエネルギー固有値 $\epsilon(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}$ が成り立つ。mは電子の質量、 $\hbar$ はプランク定数 $\hbar$ を $2\pi$ で割ったもの、kは波数である。エネルギー $\epsilon(k)$ は波数kの2次関数であるので図2.9のように書ける。



図2.9 1次元電子系のスペクトル $\mathcal{E}(\mathbf{k})$  はフェルミ波数  $\pm \mathbf{k}_{p}$  近くでは 直線で近似できる

フェルミ面近傍での電子励起のみに注目しているので電子スペクトルはフェルミ面近くで直線と近似できる。すると1次元系ではフェルミエネルギー近傍での状態を左側( $-k_F$ 近く)と右側( $k_F$ 近く)の二つの部分に分けて考えることができる。 $\pm k_F$ の十分近くで $\varepsilon(k$ )は直線で

$$\varepsilon(k) = \begin{cases} -v_F \hbar(k + k_F) + \varepsilon_F \\ v_F \hbar(k - k_F) + \varepsilon_F \end{cases}$$
(2.10)

と近似できる。 $v_F$ はフェルミ速度で図ではフェルミ面での直線の傾きである。 $\varepsilon_F$ はフェルミエネルギーを表す。運動エネルギー項を左側と右側のフェルミ速度  $-v_F$ と $v_F$ に対応する部分に分けて書くと

$$H_{0} = \sum_{k\sigma} v_{F} k (C_{k,\sigma}^{+} C_{k,\sigma} - d_{k,\sigma}^{+} d_{k,\sigma})$$
 (2. 11)

となる。演算子C<sup>+</sup>Cとd<sup>+</sup>dはそれぞれ左側と右側の生成消滅演算子である。 上のように運動エネルギー項は2次形式で書けたが、相互作用の項

 $H' = U \sum_{j} n_{j\uparrow} n_{j\downarrow\downarrow\downarrow}$  は演算子が4つかかっているため解けない。これからは相互作

?

用の項をボソン化して2次形式の形に書けるようにする。 まず、相互作用の項を4つ場合の電子ホッピング項で分けて考えることにす る。一つはウムクラップ効果の項であり、バンドが半分詰まった half-filled 状態を除くとウムクラップ項はフェルミエネルギーに十分近いところでは無視 できる。他にまた普通の電子ホッピング項H"と後方散乱の項H"がある。後方 散乱の項H'''は電子が左側の $-k_F$ 近傍と右側の $k_F$ 近傍の間を飛び移る項でまず は無視することにする。すると電子間の相互作用がH"で与えられ、朝永-ラッ ティンジャーモデルとして朝永-ラッティンジャー流体論に従う。

弱く相互作用している電子系を考えているのでフェルミ面まで電子が詰まっ たとし、電子スペクトルはフェルミ面近傍で直線として置き換えるので、密度 演算子を左側と右側に分けて考え、ここでは式(2.12)のように電荷密度 演算子 $ho_i(k)$ とスピン密度演算子 $\sigma_i(k)$ を規格化して定義する。

$$\rho_i(k) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{i\uparrow}(k) + \rho_{i\downarrow}(k)), \quad \sigma_i(k) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{i\uparrow}(k) - \rho_{i\downarrow}(k)) \quad (2. 12)$$

ただし、 $i = \Gamma(left)$  or  $i = \Lambda(Right)$  を表し、密度演算子 $\rho_{i\sigma}(k)$ は式(2.1 3)のような定義である。

$$\rho_{\Gamma\sigma}(k) = \sum_{p=-K_c}^{K_c-k} C_{p+k,\sigma}^+ C_{p,\sigma} \qquad \langle \rho_{\Lambda\sigma}(k) = \sum_{p=-K_c}^{K_c-k} d_{p+k,\sigma}^+ d_{p,\sigma} \quad (2.13)$$

ここでまず $\rho_{\Gamma}(-k)$ を計算してみよう。

$$\rho_{\Gamma}(-k) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{\Gamma\uparrow} + \rho_{\Gamma\downarrow})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{p=-K_c}^{K_c+k} (C_{p-k,\uparrow}^+ C_{p,\uparrow} + C_{p-k,\downarrow}^+ C_{p,\downarrow})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{p'=-K_c-k}^{K_c} (C_{p',\uparrow}^+ C_{p'+k,\uparrow} + C_{p',\downarrow}^+ C_{p'+k,\downarrow}) \qquad (2. 1 4)$$

$$\rho_{\Gamma}^{+}(k) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{\Gamma\uparrow}^{+} + \rho_{\Gamma\downarrow}^{+})$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{p=-K_{c}}^{K_{c}-k} (C_{p,\uparrow}^{+} C_{p+k,\uparrow} + C_{p,\downarrow}^{+} C_{p+k,\downarrow})$$
(2. 15)

(2.14)と(2.15)から-kの演算子は $\rho_{\Gamma}(-k) = \rho_{\Gamma}(k)^{+}$ のようにエル ミート共役関係であることが容易にわかる。右側とスピン演算子も同様に計算 できる。

$$\rho_i(-k) = \rho_i^+(k)$$
,  $\sigma_i(-k) = \sigma_i^+(k)$  (2.16)

ここで、先に密度演算子の交換関係を確かめるために $[
ho_{\Gamma_{\sigma}}(-k),
ho_{\Gamma_{\sigma'}}(k')]$ を計算してみる。

$$\begin{split} \rho_{\Gamma\sigma}(-k), \rho_{\Gamma\sigma'}(k') &= \rho_{\Gamma,\sigma}(-k)\rho_{\Gamma,\sigma'}(k') - \rho_{\Gamma,\sigma'}(k')\rho_{\Gamma,\sigma}(-k) \\ &= \rho_{\Gamma,\sigma}^{+}(k)\rho_{\Gamma,\sigma'}(k') - \rho_{\Gamma,\sigma'}(k')\rho_{\Gamma,\sigma}^{+}(k) \\ &= \sum_{p=-K_{c}}^{K_{c}-k'} \sum_{p'=-K_{c}}^{K_{c}-k'} (C_{p,\sigma}^{+}C_{p+k,\sigma} \cdot C_{p'+k',\sigma}^{+}C_{p',\sigma'} - C_{p'+k',\sigma}^{+}C_{p',\sigma'} \cdot C_{p,\sigma}^{+}C_{p+k,\sigma}) \\ &= \sum_{p=-K_{c}}^{K_{c}-k} \sum_{p'=-K_{c}}^{K_{c}-k'} (C_{p,\sigma}^{+}C_{p+k,\sigma} \cdot C_{p'+k',\sigma}^{+}C_{p',\sigma} - C_{p'+k',\sigma}^{+}C_{p+k,\sigma} \delta_{pp'}) \delta_{\sigma\sigma'} \\ &= \sum_{p=-K_{c}}^{K_{c}-k} \sum_{p'=-K_{c}}^{K_{c}-k'} (C_{p,\sigma}^{+}C_{p+k,\sigma} \delta_{p+k,p'+k'} - C_{p+k',\sigma}^{+}C_{p+k,\sigma} \delta_{pp'}) \delta_{\sigma\sigma'} \\ &= \sum_{p=-K_{c}}^{K_{c}-k} (C_{p,\sigma}^{+}C_{p,\sigma} - C_{p+k,\sigma}^{+}C_{p+k,\sigma}) \delta_{\sigma\sigma'} \delta_{kk'} \\ &= \delta_{\sigma\sigma'} \delta_{kk'} \sum_{p=-k_{c}}^{k+k} 1 \\ &= \delta_{\sigma\sigma'} \delta_{kk'} \frac{Lk}{2\pi} \end{split}$$

(2.17)[8]から右辺が演算子ではなく個数になっているのが非常に重要である。このような関係から次の交換関係は以下のように導かれる。

$$\left[\rho_{i}(k), \rho_{j}(k')\right] = \left[\sigma_{i}(k), \sigma_{j}(k')\right] = 0$$
(2. 18)

$$\left[\rho_{i}(-k),\rho_{j}(-k')\right] = \left[\sigma_{i}(-k),\sigma_{j}(-k')\right] = 0 \qquad (2.19)$$

式(2.18)と(2.19)から見るとボーズ系の交換関係を満たしている ことが分かる。本来のフェルミ系が密度演算子の変換によってボーズ系になっ たことを意味する。これで係数を除くと電子間相互作用項はもともと4つかか った演算子が電荷密度演算子とスピン密度演算子の2次形式の形で書ける。

$$H'' = \sum_{k} \left[ \rho_{\Gamma}(k) \rho_{\Lambda}(-k) - \sigma_{\Gamma}(k) \sigma_{\Lambda}(-k) \right] + \sum_{k} \left[ \rho_{\Gamma}(k) \rho_{\Gamma}(-k) - \sigma_{\Gamma}(k) \sigma_{\Gamma}(-k) + \rho_{\Lambda}(k) \rho_{\Lambda}(-k) - \sigma_{\Lambda}(k) \sigma_{\Lambda}(-k) \right]$$

$$(2. 20)$$

運動エネルギー項のH。も係数と定数項を除けば

$$H_{0} = \sum_{k} \left[ \rho_{\Gamma}(k) \rho_{\Gamma}(-k) + \rho_{\Lambda}(-k) \rho_{\Lambda}(k) + \sigma_{\Gamma}(k) \sigma_{\Gamma}(-k) + \sigma_{\Lambda}(-k) \sigma_{\Lambda}(k) \right]$$

$$(2. 21)$$

の形で書ける。

しかしながら、後方散乱の項を考えれば、右側と左側の演算子が混ざっている ためハミルトニアン全体は2次形式の形に書けることはない。 ここで、さらに密度演算子を

$$\begin{cases} \rho_{\Gamma}(k) = \cosh \lambda \hat{\rho}_{\Gamma}(k) + \sinh \lambda \hat{\rho}_{\Lambda}(k) \\ \rho_{\Lambda}(k) = \cosh \lambda \hat{\rho}_{\Lambda}(k) + \sinh \lambda \hat{\rho}_{\Gamma}(k) \end{cases}$$
(2.22)

(2.22)式のように1次変換で対角化する。 $\lambda$ は $\rho_{\Gamma}(k)\rho_{\Lambda}(-k)$ が消えるよう に定義し、交換関係が普通のボーズ演算子になるように規格化しなおす。する と有効ハミルトニアンHは定数を除いて式(2.23)のように書ける。

$$H = \sum_{k} u_{\rho} \left| k \right| \hat{\rho}_{i,\sigma}^{+}(k) \hat{\rho}_{i,\sigma}(k) + u_{\sigma} \left| k \right| \hat{\sigma}_{i,\sigma}^{+}(k) \hat{\sigma}_{i,\sigma}(k) + \Theta$$

(2. 23)

ただし、u<sub>o</sub>は電荷速度を表し、u<sub>o</sub>はスピン速度を表す。式(2.23)から見

ると電子の演算子が2つセットになっている。1次変換によって電荷密度励起 とスピン密度励起が分離され、お互いに独立し、ともにボーズ統計に従い1次 元弾性体の振動に対応する。つまり、電子系が完全にボソン化されたことを意 味する。朝永-ラッティンジャー理論ではさまざまな電子間相関関数 $\Theta$ がべき乗 則に従って減衰し、指数パラメータ $K_{\rho}$ と $K_{\sigma}$ によって定まることが非常に重要 である。 $K_{\sigma}$ はハバードモデルがスピン空間で回転対称性を持つため $K_{\sigma}$ =1にな る。パラメータ $K_{\rho}$ は電子系の性質が特徴づけられ、超伝導現象の相転移にも極 めて重要な役割をする。1次元系でボソン化されたときに決められたパラメー タ $K_{\rho}$ は式(2.24)のようである。

$$K_{\rho} = \left[\frac{\pi v_{F}}{\pi v_{F} + U}\right]^{\frac{1}{2}}$$
(2.24)

#### 2.3.2 2本鎖梯子

今までの1本鎖ハバードモデル理論を2本の鎖が結合している場合に拡張して みよう。ここではオンサイト斥力と最隣接サイト間のホッピングのみのハバー ドモデルを考え、1次元と同様にまずは相互作用のない場合のバンドから出発 する。

$$\varepsilon(k)_{\pm} = -[2t\cos(k)\pm t'] \qquad (2.25)$$

tは1本鎖と同じく鎖内のトランスファーで、t'は鎖間のである。2本の鎖の間には結合と反結合が存在するためトランスファーt'の前に±符号が付く。結合バンドの時を符号+、反結合バンドの時を符号-にとると2本鎖梯子モデルのバンドは上下にずれた2本のコサインバンドで描ける。(図2.10)



フェルミ面が1本のバンドにかかった時は1本鎖と同じで、2本鎖にかかった時は4つのフェルミ点近傍での相互作用を考慮しなければならない。これらがどのように繰り込まれるかは弱結合摂動での繰り込み群によって調べればrよい。バレンツ-フィッシャーらはウムクラップ散乱(図2.11)がある場合とない場合に分けて調べた結果、繰り込みの流れ方に応じてスピンモードのうちギャップレスになる本数が変わることが分かった[9,10,11]。また、m個の電荷モードギャップレスとn個のスピンモードギャップレスを持つ相をCmSnで表した。注目される相はC1S0相で、この相ではすべてのスピンモードにギャップが開き、ひとつの電荷モードにもギャップが開いている。つまりC1S0相はスピンギャップをもつ金属になって、超伝導が期待される領域である。そしてC1S0相においては、有効ハミルトニアンが1本鎖と同じ形で書けるはずである。これから計算された超伝導相関関数は式(2.26)のように表す。

$$C(r) \propto \frac{1}{r^{\frac{1}{2K_{\rho}}}}$$
 (2.26)

このように、鎖間シングレット超伝導相関のべき $(2K_{\rho})^{-1}$ は1本鎖の相関べき  $(K_{\rho})^{-1}$ と比べ長距離相関であることがわかる。2本鎖では1本鎖の時 $(K_{\rho}>1)$ と違いパラメータ $K_{\rho}$ が $K_{\rho}>0.5$ を満たせば鎖間のシングレット超伝導が支配的 になるが、C1S0相では相互作用Uが小さい時に限って超伝導が支配的である。

# 3 Pr<sub>2</sub>Ba<sub>4</sub>Cu<sub>7</sub>O<sub>15-δ</sub>系の解析

## 3.1 モデルの設定

物質  $Pr_2Ba_4Cu_7O_{15-\delta}$ 系の構造は図3.1で示している。



図3.1 物質Pr<sub>2</sub>Ba<sub>4</sub>Cu<sub>7</sub>O<sub>15-6</sub>の構造

銅酸化物系の超伝導現象についてはすでに研究されているが、Pr系は少し特別である。通常の高温超伝導体では図の上と下にあるCuO<sub>2</sub>面が超伝導現象に主な役割をするが、Pr系の物質ではPr原子の存在によりCuO<sub>2</sub>面が絶縁化され[12]、上記の図で破線に囲まれている部分が超伝導に大きな寄与を与えている。よく見ると、破線で囲まれた部分はCuOの2重鎖になっていることが容易にわかる。この物質は、2次元的な超伝導体ではなく、1次元的な超伝導体ということになる。

図3.2は図3.1の破線のCuO鎖部分だけを取り出し、銅原子のd軌道と 酸素原子のp軌道の繋がりに注目する。d電子とp電子の相互作用に注目して いるので図3.3のd-pモデルに簡単化する[13]。



図3.2 物質Pr<sub>2</sub>Ba<sub>4</sub>Cu<sub>7</sub>O<sub>15-8</sub>の構造で取り出した CuO鎖部分(図3.1の破線の部分)



図3.3 d-p電子の相互作用に
 注目したd-pモデル

14

 $\pm t_{pd}$ は銅原子のd軌道と酸素原子のp軌道での電子のホッピングを表し、  $t_{dd}, t_{pp}$ はそれぞれd軌道とd軌道、p軌道とp軌道の間の電子ホッピングを表し ている。電子のホッピングの強さは電子軌道の重なり部分によって決まれる。 図3.3でわかるようにd-p軌道がd-d、p-p軌道より重なりやすい、  $t_{pd} > t_{dd}(t_{pp})$ と予想できる。



図3.4 d-pモデルのバンド計算で 得られたバンド図

ここでは、d — band  $\ell p$  — band を分けて比較する。物質 $Pr_2Ba_4Cu_7O_{15-\delta}$ は複 雑で計算結果は後にする。ここでは物質 $YBa_2Cu_4O_8$ を例に取る。図3.4は d - p モデルのバンド計算で得られたバンド図である。図の黒丸線が物質  $YBa_2Cu_4O_8$ のバンドを表し、実線がd - p モデルのバンドを表している。比較 してみると0~ $\pi$ の間はほぼ一致している。 $-\pi$ ~0間も同じようにほぼ一致する はずである。これで、d - p モデルとしてみなしてもよいだろう。

d - pモデルのホッピング $t_{pd}$ と- $t_{pd}$ をトランスファー $t_2$ としてまとめ、 $t_{dd}$ と

*t<sub>pp</sub>*をトランスファーt<sub>1</sub>としてまとめるとd-pモデルはさらに簡単化され、有 名なハバードモデルに近似できる(図3.5)。ここでは、2.3で紹介した2 本鎖梯子モデルとはちょっと違った Zigzag ハバードモデルになる。ただ、トラ ンスファーが違うだけで、考え方は梯子モデルと同じである。つまり、2本鎖 梯子で使った理論が Zigzag ハバードモデルでも成り立つ。



図3.5 Zigzagハバードモデル

ここで、Uはクーロン相互作用を表す。

モデル簡単化について正しいのかを検討してみよう。本来複雑な物質を簡単 な Zigzag ハバードモデルとしてもいいのか。ここでは、Zigzag ハバードのバン ドと物質 YBa<sub>2</sub>Cu<sub>4</sub>O<sub>8</sub>のバンドを比較してみよう。簡単のためここでは d バンド だけを考える。



図3.6 Zigzagハバードモデルのバンド図

図3.6は横軸を波数k、縦軸をエネルギー $\varepsilon(k) = 2t_1 \cos(k) + 2t_2 \cos(2k) + \varepsilon_0$ と

したバンド図である。式 $\varepsilon(k) = 2t_1 \cos(k) + 2t_2 \cos(2k) + \varepsilon_0$ は(2.9)と同じよう に導かれた2本鎖モデルのエネルギーと波数の式である。実線は簡単化された Zigzag ハバードモデルのバンドを表し、黒丸線はの物質YBa<sub>2</sub>Cu<sub>4</sub>O<sub>8</sub>のバンド計 算の結果を表す。図3.6から実線と黒丸線がよく一致していることがわかる。

### **3.2** *K*。の解析的な計算

フェルミ面近くでの励起のみに限って考えているのでフェルミ面近傍でのバン ドだけに注目する。



図3.7 フェルミ面近くだけ注目したバンド図

図3.7の点線はフェルミ面を表し、 $k_1, k_2$ はフェルミ波数、 $v_{F1}, v_{F2}$ はフェル ミ速度を表している。図で分かるようにフェルミ速度 $v_{F1}, v_{F2}$ はフェルミ波数で の傾きであり、エネルギー $\varepsilon(k)$ をそれぞれフェルミ波数 $k_1, k_2$ で微分することで 求められる。フェルミ面でのエネルギー $\varepsilon(k_1) \ge \varepsilon(k_2)$ は等しい。( $\varepsilon(k_1) = \varepsilon(k_2)$ )。 電子がフェルミ面まで詰まり、電子密度をnとすると波数との関係は  $k_1 + (\pi - k_2) = \frac{n}{2}\pi$ を満たす。この二つの条件から $k_1 \ge k_2$ に関する正弦の余弦の値 を計算する。

$$\cos(k_1) = -\frac{t_1}{2t_2} + \frac{\frac{t_1}{t_2}(1+\cos a) - \sqrt{\Delta}}{4(1+\cos a)}, \\ \cos(k_2) = \frac{-\frac{t_1}{t_2}(1+\cos a) - \sqrt{\Delta}}{4(1+\cos a)}$$
(3. 1)

$$\sin(k_1) = \frac{\{A\}}{4(1+\cos a)} \qquad \qquad \sin(k_2) = \frac{\{B\}}{4(1+\cos a)} \qquad (3. 2)$$

ただし、

$$a = (\frac{n}{2} - 1)\pi$$

$$\Delta = \frac{t_1^2}{t_2^2} (1 + \cos a)^2 - 8(1 + \cos a)(\frac{t_1^2}{4t_2^2} - \sin^2 a)$$

$$4 = \frac{\left[(16 - \frac{2t_1^2}{t_2^2})(1 + \cos a)^2 + 8(1 + \cos a)(\frac{t_1^2}{4t_2^2} - \sin^2 a) + 2\frac{t_1}{t_2}(1 + \cos a) \cdot \sqrt{\Delta}\right]^{\frac{1}{2}}}{4(1 + \cos a)}$$

$$B = \frac{\left[(16 - \frac{2t_1^2}{t_2^2})(1 + \cos a)^2 + 8(1 + \cos a)(\frac{t_1^2}{4t_2^2} - \sin^2 a) - \frac{2t_1}{t_2}(1 + \cos a) \cdot \sqrt{\Delta}\right]^{\frac{1}{2}}}{4(1 + \cos a)}$$

フェルミ速度はエネルギーを波数で微分したものと等しいので  $\partial E(k)$ 

$$v(k) = \frac{\partial E(k)}{\partial k} = 2t_1 \sin k + 4t_2 \sin 2k \qquad (3.3)$$

である。

$$v_{F1} = 2t_1 \sin k_1 + 4t_2 \sin 2k_1$$
  
=  $2t_1 \sin k_1 + 8t_2 \sin k_1 \cos k_1$   
 $v_{F2} = 2t_1 \sin k_2 + 4t_2 \sin 2k_2$   
=  $2t_1 \sin k_2 + 8t_2 \sin k_2 \cos k_2$  (3. 4)

式(3.1)と(3.2)を式(3.4)に代入することでフェルミ速度*v*<sub>F1</sub>,*v*<sub>F2</sub>が解析的に計算できる。

擬1次元系の Luttinger-liquid パラメータ $K_{\rho}$ についてはすでに式(3.5) のように与えられた[14]。

$$K_{\rho} = \left[\frac{\pi v_{F}^{*}}{\pi v_{F}^{*} + U}\right]^{\frac{1}{2}}$$
(3.5)

ただし、 $v_F^*$ は四つのフェルミ面での有効値であり、有効フェルミ速度と呼ぶ。 有効フェルミ速度は式(3.6)で示している。

$$v_{F}^{*} = \frac{|v_{F1}v_{F2}|}{|v_{F1}| + |v_{F2}|}$$
(3.6)

式(3.4)(3.5)(3.6)からパラメータK,が解析的に計算される。

## **3.3** 超伝導転移温度<sub>T<sub>c</sub></sub>の計算

今まで議論したのは1次元系の話で実際純粋な1次元系は世の中には存在しない。現実の物質は3次元系が多い。3次元系を鎖間に結合を取り入れた擬1次元系と見なし、擬1次元系で与えられた超伝導転移温度の式(3.7)に当てはめて*T* を解析的に計算する[15]。

$$T_{c} = \frac{v}{2\pi\alpha} \left[ \frac{\lambda}{4\pi} B^{2} \left\{ \frac{\gamma}{2}, \frac{\gamma}{2} \right\} \tan \frac{\pi\gamma}{2} \right]^{1/(2-2\gamma)} \qquad (3.7)$$

ただし、vは電荷速度、 $\alpha^{-1}$ は短波長のカットオフ、 $V_j$ は鎖間のトランスファー である。  $4\alpha^2$  — 「」  $\Gamma(x)\Gamma(v)$  v = 1

$$\lambda = \frac{4\alpha^2}{vv_F} \sum V_j^2 \qquad B[x, y] = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}, \quad \gamma = \frac{1}{2 K_{\rho}}$$

式(3.7)から転移温度 $T_c$ は Luttinger-liquid パラメータ $K_p$ の関数である ことが容易にわかる。1次元系の鎖に鎖間の結合 $V_j$ を取り入れ擬1次元系とし た図が図3.8のようである。



図3.8 1次元系に鎖間の結合を取り入れた擬1次元系モデル

ここで必要なパラメータは  $\Pr$ 系のバンド計算の結果を使用した[16]。鎖内の ホッピングトランスファー $t_1 = -0.12273eV$ , $t_2 = -0.49075eV$ 、鎖間のトランスフ アー $V_1 = -0.020335eV$ , $V_2 = 0.0060401eV$ , $V_3 = -0.0097281eV$ , $V_4 = 0.0026418eV$ 。 バンド計算で得られた数値計算の値を見ると鎖間のトランスファーが鎖内のト ランスファーよりかなり弱いことが分かる。これで物質  $\Pr_2 Ba_4 Cu_7 O_{15-\delta}$ は擬 1 次 元系として考えてもよい。

上の鎖内、鎖間のトランスファーを入れて計算された転移温度 $T_c$ のグラフは図3.9(b)のようである。



この計算では $t_1, t_2$ しかまで考えてないのだが、参考として $t_3, t_4$ まで入れて時の計算と比べると $n = 0.6, \alpha = 2$ を取った場合 $T_c = 24K(U = 1), T_c = 12K(U = 2)$ であり、特に $t_3, t_4$ を無視した結果と大差はない。

しかし、トランスファーUと $\alpha$ の値を決めるのは非常に難しい。 $\alpha = 3, \alpha = 4$ の ときの転移温度のグラフは図3.10で示している。いろいろな値の計算結果 から見ると $\alpha = 2, U = 2eV$ のとき、実験で得られた値 $T_c \sim 20K$ と近いことがわか る。Uに関してはすでにU = 2のときが最適だと知られている。(図3.12)Cutoff  $\alpha$ ははっきりとした値はないのだが、ボソンの広がり程度の値なので2以上だと 予想される(図3.11)。



20



# 3.5 YBa<sub>2</sub>Cu<sub>4</sub>O<sub>8</sub>系ついての計算比較

Y系とPr系の物質は構造がよく似ていてほとんどほとんど同じだと思ってよい。 ここでは物質 YBa<sub>2</sub>Cu<sub>4</sub>O<sub>8</sub>についての FLEX 近似計算結果[17]と平均場近似での 計算結果を比較してみよう。



図3.13 FLEX近似での計算結果 2重鎖部分のパラメータを使って計算 ここで使ったパラメータの値は $t_1 = 0.095eV$ 、  $t_2 = -0.43eV$ 、  $V_1 = 0.015eV$ 、  $V_2 = -0.012eV$ 、  $V_3 = -0.015eV$ 、  $V_4 = -0.008eV$ である[17]。FLEX 近似で計算

された結果が図3.13で、平均場近似で計算された結果が図3.14で表わ す。電子密度n=0.6の時を比較すると FLEX 近似の結果は17K であるが、平 均場近似は26K である。本研究で使われたパラメータの値が上のパラメータ の値より小さいため、これから予想されるのは本研究で使ったパラメータを FLEX 近似で計算するともっと低い転移温度が得られる。

# 3.5 K<sub>a</sub>の近似の検討

パラメータK,の計算で平均場近似を使ったが、どこまで正しいのか?



図3.15 平均場近似と数値計算結果の比較

図3.15の左図は平均場近似を使った $n, \frac{t_1}{t_2}, K_\rho$ の関係を示し、右図は数値計 算で計算された $n, \frac{t_1}{t_2}, K_\rho$ の関係を示している[14]。今回の $K_\rho$ の計算で使われた トランスファーの値は $t_1 = -0.12273, t_2 = -0.49075$ なので $\frac{t_2}{t_1} \approx 4$ のときに相当する。  $\frac{t_2}{t_1} \approx 4$ のときの平均場近似と DMRG の結果との比較してみるとn = 1近くで $K_\rho$ の 値がずれ、それ以外のところでは使えることがわかる。原因としてはn = 1近傍 ではウムグラップ効果により絶縁化され、 $K_\rho$ の値がずれるとみられる。このと きの平均場近似によって $K_\rho$ の値は出されていたが、解析的ではなかった。図3. 9 (b) で電子密度が 0.6~0.8の間では平均場近似でき、ほぼ正しい値が得られ

るものと思われる。

# 4 まとめ

銅酸化物高温超伝導体の一種である Pr<sub>2</sub>Ba<sub>4</sub>Cu<sub>7</sub>O<sub>15-8</sub>で超伝導現象に大きく寄与 している1次元的なCu0の2重鎖構造から電子構造をあらわすモデルとして、 銅原子(d軌道)と酸素原子(p軌道)の繋がりを単純化し、d軌道だけからな る1次元 Zigzag 鎖ハバードモデルとして簡単化した。その上、このモデルの電 子状態を、一次元電子系の一般的な理論形式である Luttinger 流体論に基づき 解析した。この理論形式ではLuttinger liqid パラメータ K。と呼ばれる値が電 子状態を表す重要なパラメータとなっているが、この値は Zigzag 鎖ハバードモ デルのエネルギーと波数の関係(分散式)から、平均場近似を用いて計算した。 さらに超伝導転移温度 T。を理論的に求めるため、バンド計算により得られてい る Zigzag 鎖間の結合も取り入れることにより擬1次元系として扱い、K。の値に より表されている擬1次元系に対する超伝導転移温度の式に当てはめて、T<sub>c</sub>の 値を解析的に求めた。電子密度nやd軌道における電子間クーロン相互作用 U の値は、現在の所バンド計算や実験結果からは得られておらず、高温超伝導の 理論でよく使われる推定値を用いるしかないが、それらのパラメータの値はい ろいろの数値を代入して計算した結果、α=2,U=2のとき実験で得られたもの と一番近いことがわかった。

今回の研究では Pr 系の転移温度を1 次元 Zigzag ハバードモデルを使って計算し、実験結果を説明した。そして Y 系についても同様に転移温度を計算し、その結果が実験と矛盾しないことが分かった。最後に K<sub>o</sub>の近似の検討を行い、Pr 系では平均場近似が使えることが分かった。

# 5 謝辞

本研究を進めるあたりご指導をいただいた佐野和博教授に心から深く感謝申 し上げます。本研究をやり遂げることができたのも教授のご指導によるものだ と思います。数値計算やプログラムなど普段の勉学でご指導を頂いた鳥飼正志 先生にも感謝申し上げます。また、いつも助言を頂いた山下護教授にも感謝し ます。最後に、充実した修士課程を過ごすことができたのも、物性物理学研究 室の皆様の支えのおかげだと思います。誠にありがとうございました。

٠.

\*

.

# 6 参考文献

- [1] H. Kamerlingh Onnes, Comm. Phys. Lab. Univ. Leiden, No. 119, 120, 133 (1991).
- [2] J. Bardeen, L. N. Cooper and J. R. Schrieffer, Phys. Rev. 108 (1957) 1175.
- [3] M. Matsukawa, Y. Yamada, M. Chiba, H. Ogasawara, T. Shibata, A. Matsushita, and Y. Takano: Physica C 411 (2004) 101.
- [4] Y. Yamada and A. Matsushita: Physica C 426- 431 (2005) 213.
- [5] V. J. Emery: in Highly Conducting One-Dimensional Solids, ed. J. T. Devreese, R. Evrand, and V. van Doren (Plenum, New York, 1979)p. 327.
- [6] J. So 1yom: Adv. Phys. 28 (1979) 201.
- [7] J. Voit: Rep. Prog. Phys. 58 (1995) 977.
- [8] K. Terakura et al. : J. Phys. F12, 1661 (1982); 金森順次郎ほか:岩波講座「現 代の物理学」第7巻「固体―構造と物性」(岩波書店, 1994年), p. 109.
- [9] L. Balentz and M. P. A. Fisher: Phys. Rev. B 53 (1996) 12133.
- [10] M. Fabrizio: Phys. Rev. B 54 (1996) 10054.
- [11] V. J. Emery, S. A. Kivelson, and O. Zachar: Phys. Rev. B 59 (1999) 15641.
- [12] R. Fehrenbacher and T. M. Rice: Phys. Rev. Lett. 70 (1993) 3471.
- [13] K. Sano, Y. 0 no, and Y. Yamada: J. Phys. Soc. Jpn. 74 (2005) 2885.
- [14] S. Nishimoto, K. Sano and Y. Ohta: Phys. Rev. B 77 (2008) 85119.
- [15] H. J. Schultz and C. Bourbonnais: Phys. Rev. B 27 (1983) 5856.
- [16] 幅口 et al. 日本物理学会発表(2006秋)
- [17] T. Nakano, K. Kuroki, and S. Onari: Phys. Rev. B 76 (2007) 014515.